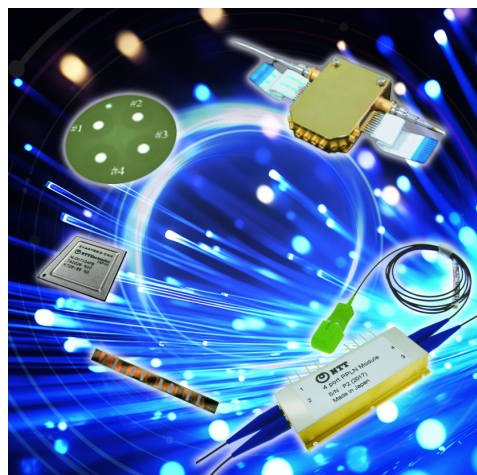




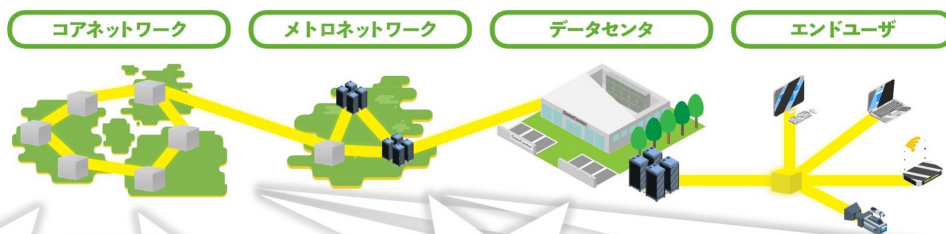
背景

IOWN 2.0以降の高速大容量の光パスを支える、さまざまな先端デバイスを研究開発しています。先端フォトンクスデバイスと電気デバイスの融合・集積化を推進し、多様なユースケースに対応した経済的なAll-Photonics Network実現をめざします。

成果の概要

NTTでは光電融合デバイスの開発などに係る機能をスピンオフ後も、引き続きAPN (All-Photonics Network) を実現するためのデバイス研究開発を推進しています。この展示では、さまざまな先端デバイスを紹介します。

APNを支える光・電子デバイス技術 ～IOWNの高速大容量光パスを実現するキーデバイス～



光 の道を増やす 	信 号の色を変える 	超 高速信号処理 	色 を問わない切換え
マルチコアファイバ (AS研/未来研)	波長帯変換デバイス (先デ研)	1Tbps級デバイス (未来研/DIC/先デ研)	超広帯域光スイッチ (DIC)

技術のポイント

- 先端デバイス技術を駆使することで超大容量・超高速通信を具現化
- 光スイッチを超広波長帯域で動作できるようにすることで機能性を向上
- 波長帯変換で高速大容量の光パスを高度にハンドリング

この研究がもたらす未来

大容量、低遅延、低消費電力なAPNに必要なキーデバイスを実現し、IOWNのさまざまなサービスを支えます。

出展企業

日本電信電話株式会社

問い合わせ先

rdforum-exhibition@ml.ntt.com